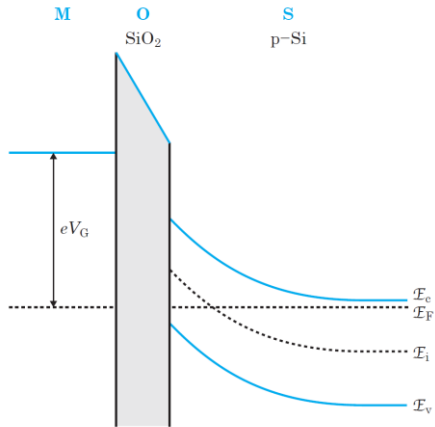
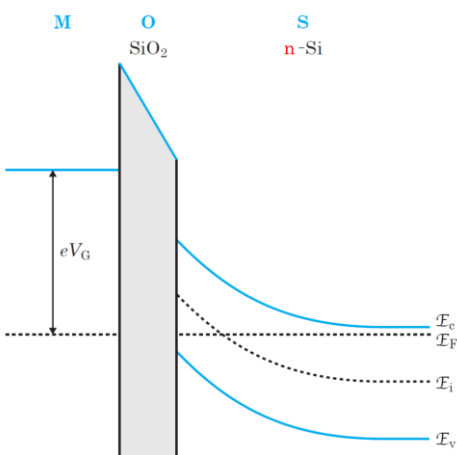


頁	行	誤	正
92i	式 (4.16)	$E_2 = \frac{1}{2}(E_s + E_p) - \left[ \left\{ \frac{1}{2}(E_s - E_p) \right\}^2 + 16H_{s1,p2}^2 \right]^{1/2} \quad (2重縮退)$ $E_3 = E_p + 4H_{p1,p2} \quad (2重縮退)$ $E_4 = E_p - 4H_{p1,p2} \quad (2重縮退) \quad (4.16)$	$E_2 = \frac{1}{2}(E_s + E_p) - \left[ \left\{ \frac{1}{2}(E_s - E_p) \right\}^2 + 16H_{s1,p2}^2 \right]^{1/2} \quad (2重縮退)$ $E_3 = E_p + 4H_{p1,p2} \quad (2重縮退)$ $E_4 = E_p - 4H_{p1,p2} \quad (2重縮退) \quad (4.16)$ <p style="text-align: center;">※大カッコ [ ] に 1/2 乗を追加</p>
245	図 12.5	 <p>図 12.5 pチャネル型MOSFETのバンド構造 ドナーの準位は省略している。</p>	 <p>図 12.5 pチャネル型MOSFETのバンド構造 ドナーの準位は省略している。</p> <p style="text-align: center;">※基板 S は p 型 Si ではなく n 型 Si</p>
奥付	著者紹介	1998年 博士(理学) 東北大学	1996年 博士(理学) 東北大学